

SURFACE MOUNT

GLASS PASSIVATED SILICON RECTIFIER

VOLTAGE RANGE 50 to 1000 Volts CURRENT 2.0 Amperes

FEATURES

- * Glass passivated device
- * Ideal for surface mounted applications
- * Low leakage current
- * Metallurgically bonded construction
- * Mounting position: Any
- * Weight: 0.098 gram

MECHANICAL DATA

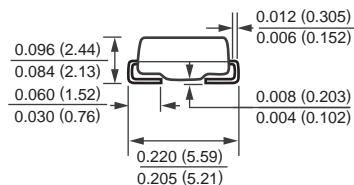
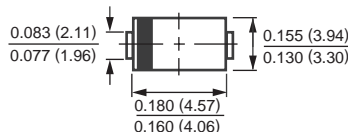
- * Epoxy : Device has UL flammability classification 94V-0

MAXIMUM RATINGS AND ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Ratings at 25 °C ambient temperature unless otherwise specified.
 Single phase, half wave, 60 Hz, resistive or inductive load.
 For capacitive load, derate current by 20%.



DO-214AA



Dimensions in inches and (millimeters)

MAXIMUM RATINGS (At TA = 25°C unless otherwise noted)

RATINGS	SYMBOL	FM201	FM202	FM203	FM204	FM205	FM206	FM207	UNITS
Maximum Recurrent Peak Reverse Voltage	VRRM	50	100	200	400	600	800	1000	Volts
Maximum RMS Voltage	VRMS	35	70	140	280	420	560	700	Volts
Maximum DC Blocking Voltage	VDC	50	100	200	400	600	800	1000	Volts
Maximum Average Forward Rectified Current at TA = 75°C	IO	2.0							Amps
Peak Forward Surge Current 8.3 ms single half sine-wave superimposed on rated load (JEDEC method)	IFSM	50							Amps
Typical Thermaesistance	(Note 2)RθJL	20							°C/W
	(Note 3)RθJA	50							°C/W
Typical Junction Capacitance (Note 1)	CJ	30							pF
Operating and Storage Temperature Range	TJ,TStg	-55 to + 150							°C

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (At TA = 25°C unless otherwise noted)

CHARACTERISTICS	SYMBOL	FM201	FM202	FM203	FM204	FM205	FM206	FM207	UNITS	
Maximum Instantaneous Forward Voltage at 2.0A DC	VF					1.1				Volts
Maximum Average Reverse Current at Rated DC Blocking Voltage	@ TA = 25°C					5.0				uAmps
	@ TA = 125°C					125				uAmps

- NOTES : 1. Measured at 1 MHz and applied reverse voltage of 4.0 volts.
 2. Thermal resistance junction to terminal, 5X5mm² copper pads to each terminal.
 3. Thermal resistance junction to ambient, 5X5mm² copper pads to each terminal.

RATING AND CHARACTERISTIC CURVES (FM201 THRU FM207)

FIG. 1 - TYPICAL FORWARD CURRENT DERATING CURVE

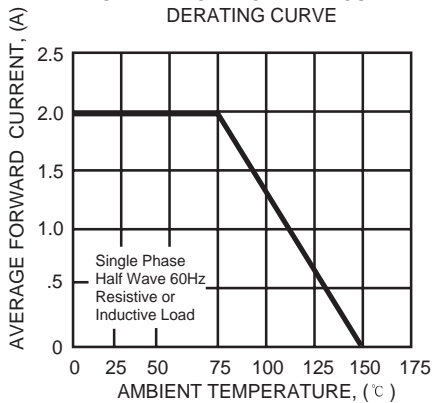


FIG. 2 - TYPICAL INSTANTANEOUS FORWARD CHARACTERISTICS

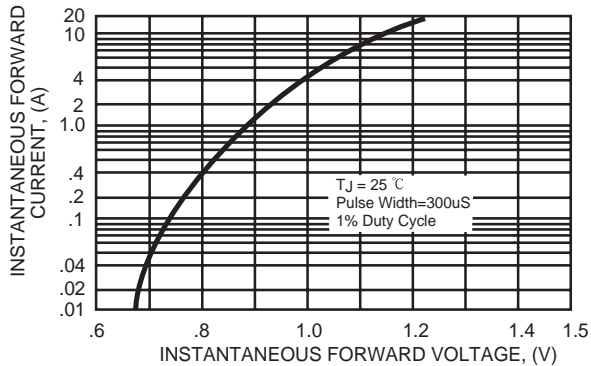


FIG. 3 - MAXIMUM NON-REPETITIVE FORWARD SURGE CURRENT

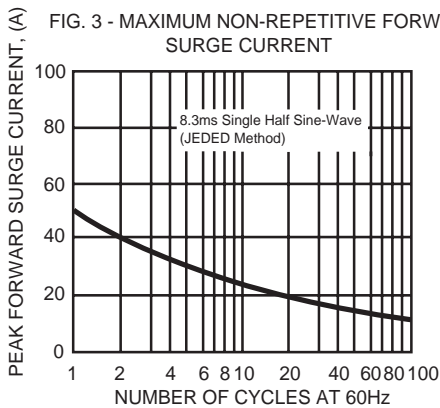


FIG. 4 - TYPICAL REVERSE CHARACTERISTICS

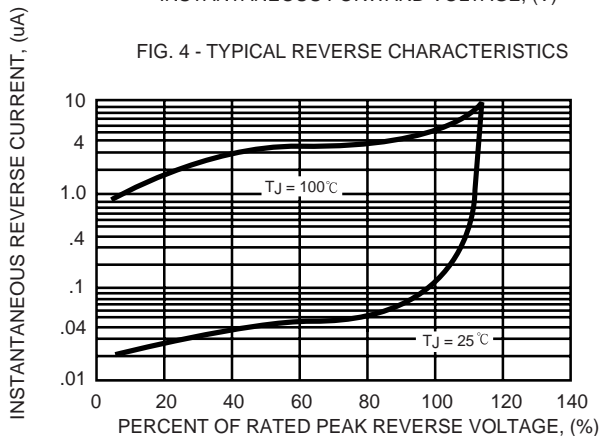
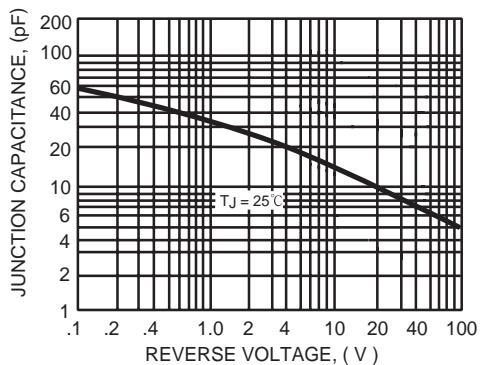
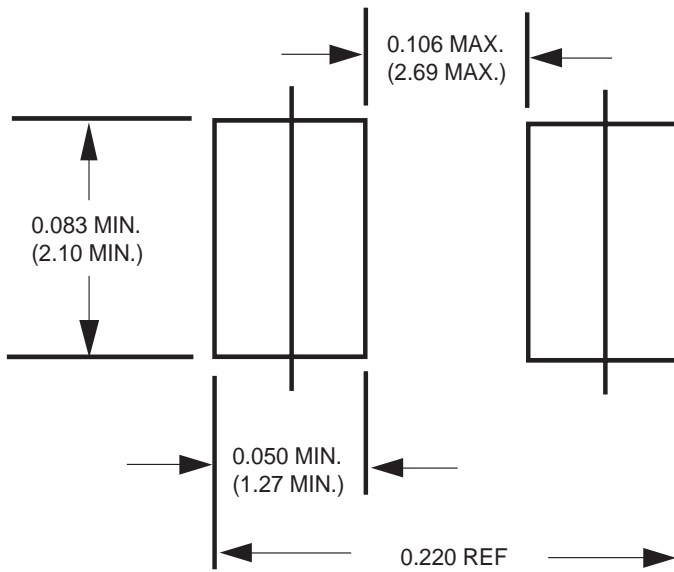


FIG. 5 - TYPICAL JUNCTION CAPACITANCE



Mounting Pad Layout



Dimensions in inches and (millimeters)



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.